# $Si_m$ 笼状分子的结构研究\*

#### 汪 雷 杨德仁<sup>†</sup>

(浙江大学材料科学与工程系, 硅材料国家重点实验室, 杭州 310027)(2008 年 8 月 26 日收到 2008 年 9 月 13 日收到修改稿)

采用基于密度泛函的第一性原理计算方法 构建了 Si<sub>so</sub>笼状分子的模型,并对其结构和电学特性进行了考察.研究发现 经过结构优化计算 Si<sub>so</sub>分子从 *I*<sub>h</sub> 高对称性下降为 *T*<sub>h</sub> 但仍然保持较好的笼状结构. 对 Si<sub>so</sub>笼状分子的稳定性、轨道分布和电荷分布等性质进行了分析和讨论.

关键词:Si<sub>80</sub>, 富勒烯, 结构 PACC: 6146, 7115

#### 1.引 言

自 1985 年首次发现 C<sub>a</sub>笼状分子以来,类似的 富勒烯结构分子材料引起了研究人员的极大兴趣与 关注[1]. 一个富勒烯笼状分子由五边形和六边形组 成,并且符合 Euler 规则:具有 N 个顶点的富勒烯分 子由 12 个五边形和 N/2-10 个六边形组成,其中 N≥20. 这种高度对称特性的结构使得富勒烯分子 具有独特的物理化学性质,并在电子、生物和超导等 方面具有重要的应用价值. Si 与 C 同属 Ⅳ 族元素, 由于其在半导体领域的重要作用,人们期望可以制 备出 Si 原子组成的富勒烯结构分子并应用在电子 器件中,因此,人们在实验和理论上对硅的笼状分 子展开了大量的研究工作,其中最受人们关注的是  $Si_{00}$ 分子<sup>[2-4]</sup>. 但到目前为止  $Si_{00}$ 的笼状富勒烯结构 还未在实验上制备出来. 这主要是由于 Si 与 C 的 电子结构性质不同 ,C 趋向于 sp2 杂化而 Si 则趋向 于 sp3 杂化. 这种性质导致了 C 很容易形成层状结 构 ,而 Si 则难以形成由层状分子组成的笼结构 . 因 此,目前对 Si<sub>00</sub>的研究主要集中在理论计算方面.我 们研究组提出采用 H 原子外钝化 Si<sub>a</sub>的悬挂键,形 成稳定的 sp3 杂化结构 ,通过计算得到了具有高度 I<sub>h</sub> 对称性的完美富勒烯结构分子<sup>[5]</sup>. 此外,对于比 Si<sub>60</sub>尺寸更大的 Si<sub>70</sub>分子,也有人进行了研究<sup>6,7]</sup>.但

是 ,对硅原子数大于 70 的硅笼状分子的研究则还未 见报道.在 C 的大分子富勒烯结构中 ,C<sub>80</sub> 理论上具 有多种同素异构体 ,其中一种异构体具有和 C<sub>60</sub>相同 的最高对称性 *I*<sub>h</sub>.探索是否存在与 C<sub>80</sub>类似的 Si<sub>80</sub>分 子是一个有趣的研究课题.因此 ,本文构建了 Si<sub>80</sub>分 子的原子模型 ,并提出通过基于密度泛函的第一性 原理计算方法研究 Si<sub>80</sub>分子的结构和电学特性.研 究结果有助于人们进一步认识大分子 Si 笼状结构 的特性及为寻找可能的实验制备方法提供参考.

### 2. 计算模型和方法

Si<sub>80</sub>分子的原子模型采用与 C<sub>80</sub>相同的拓扑结构,由 80 个 Si 原子组成,但 Si<sub>80</sub>笼直径比 C<sub>80</sub>笼直径 更大. Si—Si 初始键长设为 0.233 nn( 连接 2 个六边 形的键长)和 0.235 nn( 连接五边形和六边形的键 长). Si<sub>80</sub>的初始对称性为  $I_h$ ,在结构优化过程中几 何结构无对称性限制.

第一性原理计算采用基于密度泛函理论的 Dmol<sup>3</sup> 量子力学计算程序模块<sup>[8]</sup>,采用 DNP 基组,电 子的交换关联作用取广义梯度近似,密度泛函采用 PW91. 能量和力收敛判据分别小于 110.5 × 10<sup>-26</sup> J 和 221 × 10<sup>-23</sup> J/nm. 模型中所有原子均自由位移直 至得到能量最小化.

<sup>\*</sup> 国家自然科学基金(批准号 50544006),教育部长江学者和创新团队发展计划(批准号:IRT0651)和国家重点基础研究发展计划(批准 号 2007CB6130403)资助的课题。

<sup>†</sup> 通讯联系人. E-mail:mseyang@zju.edu.cn

### 3. 结果和讨论

3.1.Si<sub>80</sub>分子团簇的结构和稳定性

初始计算模型为 *I<sub>h</sub>* 对称性 Si<sub>so</sub>宠状分子结构, 它包含 12 个五边形和 30 个六边形,符合富勒烯结 构规则,见图 I(a)所示.经过几何结构优化计算,得 到能量稳定的分子结构,如图 I(b)所示.从图 1 可 以看出 *S*i<sub>so</sub>分子结构发生了一定的变化,但仍然保 持宠状的形态.通过几何结构对称性分析可以知道 此时 Si<sub>80</sub> 团簇的对称性下降为  $T_h$ ( 位移误差小于 0.01 nm) 具有 3 个  $C_4$  对称轴、4 个  $C_3$  对称轴. 笼 结构顶点处的部分 Si 原子由外凸转为凹陷,形成折 叠的不规则球形结构. 每个凸出的 Si 原子相邻成键 的 3 个 Si 原子均为凹陷,形成不规则的四面体结 构. 这种结构有利于降低整个团簇的能量. 由于 Si<sub>80</sub>分子团簇仍然具有较高的对称性, Si—Si 键可区 分为 4 种,键长分别为 0.227  $\rho$ .229  $\rho$ .230 和 0.231 nm 所有成键均为这 4 种键组成. 图 1(b)中标出了 Si<sub>80</sub>分子部分键的键长.



图 1 Si<sub>80</sub>分子的初始原子结构模型和优化计算后的结构模型 (a)初始分子结构 具有  $I_h$  对称性 (b)结构优化计算后的分子结构 具有  $T_h$  对称性

通过对图 1(a)中 Si<sub>80</sub>分子初始结构的成键键角 分析可以知道,其等边五边形键角均为 108°,六边形 由于存在两种键长,键角分别为 117°和 121°. 经过 结构优化计算,图 1(b)中的五边形和六边形均发生 变形,各顶点 Si原子不再处于同一个平面内. 因此, 键角也发生变化,五边形键角分化为三种,分别为 96°,110°和 113°;六边形键角则分化为 105°,107°, 119°,123°,124°和 126°.

在利用第一性原理计算分子结构的过程中,原 子沿受力方向的位移可以使得分子团簇总能降低, 由此从初始结构出发可以得到较为稳定的优化结 构,但此结构未必是团簇能量最低的基态.我们可 以通过计算分子团簇的平均结合能(binding energy) 来考察分子结构的稳定性.计算可得结构优化后的 Si<sub>80</sub>分子平均每个原子的结合能 3.834 eV,对比文献 [5]中给出的 Si<sub>60</sub>团簇平均每个原子的结合能为 3.823 eV,可以看出 Si<sub>80</sub>笼状分子的平均结合能较高,但两者相差不大.因此,两种分子结构应具有相似的稳定性.

#### 3.2. Si<sub>80</sub>分子团簇的电学性能

对稳定的 Si<sub>80</sub>笼状分子,我们计算了它的分子 轨道结构.发现 Si<sub>80</sub>分子的最高占据态轨道(HOMO) 和最低未占据轨道(LUMO)之间的能隙为 0.24 eV, 与先前计算得到的 Si<sub>60</sub>团簇的能隙 0.62 eV 相比有 所减小(见文献[5]).图 2 分别给出了 Si<sub>80</sub>分子的 HOMO 和 LUMO 的分布形态.从图 2 可以看出, HOMO 和 LUMO 大部分集中于 Si<sub>80</sub>笼结构的某些凹 陷硅原子周围,这也意味这些凹陷的 Si 原子具有较 高的化学活性,易与其他原子发生化学反应.

由于对称性降低 ,Si<sub>80</sub>分子的每一个 Si 原子所 处的环境不再完全相同. Si 原子上的电荷分布也可



图 2 Si<sub>80</sub>分子的 HOMO 轨道和 LUMO 轨道分布 (a)HOMO (b)LUMO



图 3 Si<sub>80</sub>分子上硅原子电荷分布示意图

能发生变化.对 Si<sub>80</sub>笼状结构进行了密立根电荷分

布计算,结果如图 3 所示. 从图 3 可以看出,原子间 电荷转移量很小,最大的达到 0.1e,这是因为 Si 原 子之间形成的是不对称的共价键.而凸出的 Si 原子 均带负电荷,电量约为 0.07e,凹陷的 Si 原子均带正 电荷,电量约为 0.04e,少数 Si 原子带正电荷,电量 为 0.1e. 由此可见,原来呈电中性的 Si<sub>80</sub>笼经过几何 结构优化后形成外层(凸出 Si 原子)负电包裹内层 (凹陷 Si 原子)正电的核壳结构,这种电荷分布可能 在电磁性质上具有一些特殊的应用.

### 4.结 论

本文构建了  $Si_{80}$ 分子的笼状结构原子模型,并 采用第一性原理计算方法得到它的稳定原子结构. 研究发现, $Si_{80}$ 笼状分子具有  $T_h$  对称性,HOMO-LUMO 能隙为 0.24 eV. 电荷分布表现为外凸原子带 负电,内凹原子带正电.

- [1] Kroto H W ,Heath J R ,Obrien S C 1985 Nature 318 162
- [2] Vijay K , Yoshiyuki K 2001 Phys. Rev. Lett. 87 045503
- [3] Sun Q, Wang Q, Jena P, Rao B K, Kawazoe Y 2003 Phys. Rev. Lett. 90 135503
- [4] Li Y L ,Luo C L Acta Phys. Sin. 51 2589(in Chinese)[李延龄、

罗成林 2002 物理学报 51 2589]

- [5] Wang L ,Li D S ,Yang D R 2006 Mol. Simul. 32 663
- [6] Li B X ,Liu J H Zhan S C 2005 Eur. Phys. J. 32 59
- [7] Piqueras M C ,Crespo R ,Tomas F 1995 J. Mol. Struct. 330 177
- [8] Delley B J 2000 Chem. Phys. 113 7756

## The structure study for Si<sub>80</sub> cages \*

Wang Lei Yang De-Ren<sup>†</sup>

(State Key Laboratory of Silicon Materials, Department of Materials Science and Engineering, Zhejiang University, Hangzhou 310027, China) (Received 26 August 2008; revised manuscript received 13 September 2008)

#### Abstract

The structure study for large  $Si_{80}$  cages using *ab initio* calculations based on density functional theory is reported. The results show that Si cages are distorted from perfect  $I_h$  symmetry to  $T_h$  symmetry. The geometry and electronic properties of  $Si_{80}$  cages are discussed.

Keywords : Si<sub>80</sub> , fullerene , structure PACC : 6146 , 7115

<sup>\*</sup> Project supported by the National Natural Science Foundation of China (Grant No. 60544006), the Cheung Kong Scholars and Innovative Research Team Program in University from Ministry of Education, China (Grant No. IRT0651) and State Key Development Program for Basic Research of China (Grant No. 2007CB6130403).

<sup>†</sup> Corresponding author. E-mail:mseyang@zju.edu.cn